■ 公募情報

公募No.	2027T-5
職種	有期研究技術員
部署	未来ICT研究所小金井フロンティア研究センターグリーンＩＣＴデバイス研究室
業務名	酸化ガリウムデバイスの設計・試作技術に関する研究開発支援
業務内容	新規ワイドギャップ半導体である酸化ガリウム（Ga_2O_3）を中心とした電子デバイスの研究開発において、TCADを用いたプロセス／デバイスシミュレーションによるデバイス構造の設計・特性解析を主に担当する。あわせて、クリーンルームにおけるデバイス試作プロセス、作製したデバイスの電気特性評価、実験結果とシミュレーションの比較解析による設計へのフィードバックを担当する。また、実験装置・計算機環境の運用管理、実験データの整理・管理、外部施設の利用等、研究室が実施する研究開発に係る技術業務を担当する。
自発的な研究活動等の実施に関して	機構内外の競争性を有する研究資金（科研費等）への申請資格があります。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2の対象業務該当の有無	【有】
応募要件	【必須】 理工系（電気・電子・物理・材料等）の大学、大学院又は高等専門学校を卒業・修了した者 半導体デバイス又は電子材料に関する知識を有すること 半導体デバイスの解析（シミュレーションを含む）に関する業務を主体的に遂行できること デバイスの作製及び評価に関する業務にも従事できること クリーンルーム内での実験業務に従事できること Excel等でデータの集計・グラフ化が正確に行えること 英語で書かれた技術文書・マニュアルの読解に抵抗がないこと 協調性を持ち、研究室メンバーと円滑に意思疎通・連携ができること 【あれば望ましい】 TCAD（Silvaco Victory等）によるプロセス又はデバイスシミュレーション経験 クリーンルームでの半導体デバイスプロセス経験 デバイスの電気特性評価の経験 半導体デバイスに関する研究開発又は製品開発の経験 熱解析、放射線影響解析又はマルチフィジックス解析の経験 ワイドギャップ半導体（SiC、GaN、Ga_2O_3等）に関する知識 外国籍研究員を含むチーム内での英語による日常的なコミュニケーション能力（流暢な会話力は問わない） 学会発表、論文投稿又は特許出願の経験
募集人員	1 人
本年度契約期間	採用日　～　令和10年3月31日（更新の可能性：有り）
更新した場合の雇用期間（又は期日）	一定の条件を満たした場合に、採用日より最長5年
給与(基本給)	485,000円　～　516,000円/月 本給は学歴や職務経験等を考慮し決定します。ただし、本給については、国家公務員の給与に準拠していることから国家公務員の給与に改正があり、当機構労働組合等の合意後に本給の改定が生じた場合は変更する。
勤務地名称	本部 (東京都小金井市)
勤務頻度	週5日（週37時間30分勤務）　※時間外労働有

※従事する業務及び勤務地の変更の範囲：原則として変更無し
※部署の名称、勤務地の名称、及び業務名や業務内容内の表現に関しては、組織改編等により変更となる場合があります。

NICT有期雇用職員公募情報：https://www.nict.go.jp/employment/apply.html